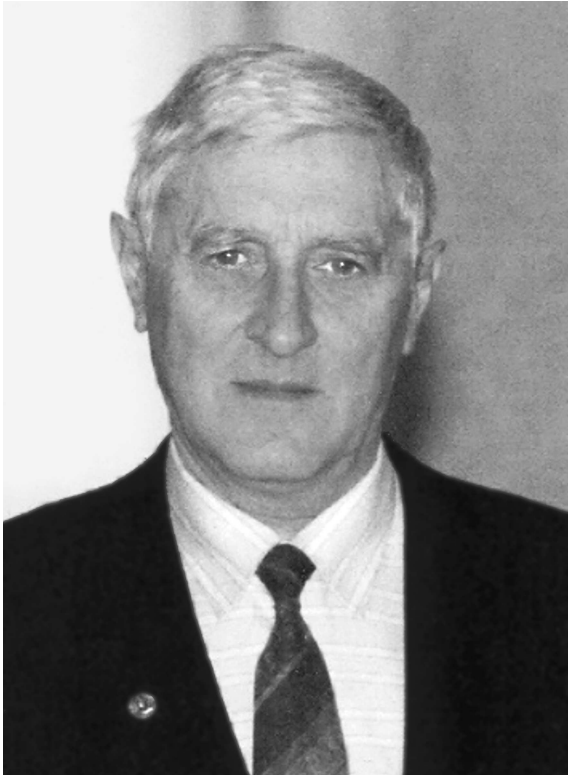


Игорь Георгиевич Неизвестный

(к 80-летию со дня рождения)



26 ноября 2011 года исполнилось 80 лет Игорю Георгиевичу Неизвестному.

И.Г. Неизвестный закончил в 1956 г. Московский энергетический институт по специальности „диэлектрики и полупроводники“. Это был первый выпуск специалистов такого профиля в нашей стране. Научная деятельность молодого специалиста началась в Физическом институте им. П.Н. Лебедева Академии наук в лаборатории академика Б.М. Вула, под руководством тогда ещё кандидата ф.-м.н. А.В. Ржанова, творческий союз и дружба с которым продолжалась затем много лет. Перед молодым исследователем была поставлена задача — исследовать поверхностные состояния, ответственные за рекомбинацию и захват на поверхности германия, основного в то время материала полупроводниковой электроники. Уже в том же 1956 г. по результатам дипломной работы вышла в свет первая научная работа. Исследования продолжились далее, расширившись в изучение природы и механизмов рекомбинации и захвата на границе раздела полупроводника с внешней средой. Результаты этой работы позволили сформировать физические основы приборов на основе структур металл–диэлектрик–германий и исследовать характеристики этих приборов.

В 1962 г. А.В. Ржанов переезжает в Новосибирский Академгородок, где ему поручают организацию Института твёрдого тела и полупроводниковой электроники (после объединения с Институтом радиоэлектроники — Институт физики полупроводников, ИФП). И.Г. Неизвестный был приглашен А.В. Ржановым, а затем и назначен распоряжением Президиума Сибирского отделения Академии наук заместителем директора этого института. После этого он принимает активное участие в создании и развитии ИФП СО РАН. Это — строительство уникального термостатированного корпуса, оснащение оборудованием, приборами лабораторий и вспомогательных подразделений, подбор кадров, организация научных исследований, и везде Игорь Георгиевич проявляет незаурядные способности учёного и организатора. Эта деятельность была высоко оценена Правительством страны, наградившим И.Г. Неизвестного в 1971 г. Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1980 г. после защиты докторской диссертации научные интересы И.Г. Неизвестного связаны с разработкой высокочувствительных многоэлементных фотоприемников инфракрасного излучения. Сюда входили и технология получения тонкоплёночных гетероструктур, и исследование их взаимодействия с излучением, и поведение их при криогенных температурах. По результатам этой работы И.Г. Неизвестному с соавторами в 1995 г. была присуждена Государственная премия Российской Федерации по науке и технике „За открытие, экспериментальное и теоретическое исследование нового класса фоточувствительных полупроводниковых материалов“.

В новом веке сфера научной деятельности И.Г. Неизвестного, кроме перечисленных выше проблем, включает компьютерное моделирование процессов на поверхности полупроводника, разработку элементной базы квантового компьютера, квантовую (одnofотонную) криптографию, микро- и наносенсорику.

С 1973 по 1980 г.г. Игорь Георгиевич — заведующий лабораторией Физики и технологии германиевых МДП структур, с 1980 по 2004 г.г. — заместитель директора ИФП СО РАН. С 2004 г. он является советником РАН, заведующим отделом „Тонкоплёночные структуры для микро- и фотоэлектроники“.

В 1966 г. И.Г. Неизвестный защитил кандидатскую диссертацию, а в 1980 г. ему была присуждена степень доктора физико-математических наук и в том же году присвоено звание профессора. В 1990 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности „элементная база вычислительной техники“.

С 1988 по 2010 г.г. — заведующий филиалом кафедры „Полупроводниковые приборы и микроэлектроника“ Новосибирского государственного технического универ-

ситета в ИФП СО РАН. Много лет он читает курсы по физическим основам твердотельных устройств микро- и нанoeлектроники. Он является автором и соавтором 170 научных работ, из них 7 книг, в том числе первые в России учебные пособия по основам нанoeлектроники.

Под руководством И. Г. Неизвестного защищено 7 докторских и 15 кандидатских диссертаций. Много лет руководит работами, поддерживаемыми грантами РФФИ, выполнением проектов Президиума РАН, Отделений РАН и интегральных проектов СО РАН,

И. Г. Неизвестный по-прежнему принимает активное участие в жизни Института физики полупроводников, Сибирского отделения РАН и научной общественности страны. Он является членом научного совета РАН по физике полупроводников, заместителем председателя объединенного совета по физическим наукам СО РАН, руководителем Программы СО РАН „Твердотельные устройства микро- и нанoeлектроники“, зам. главного редактора журнала „Микроэлектроника“, членом редколлегии журналов „Поверхность“, „Sensors electronics and microsystem technologies“, „Украинский физический журнал“, членом-основателем Азиатско-Тихоокеанской академии материаловедения, членом Американского физического общества и Японского физического общества.

В 2010 г. И. Г. Неизвестный был избран Почётным профессором Одесского национального университета.

От всей души поздравляем Игоря Георгиевича со славным юбилеем и искренне желаем ему крепкого здоровья, личного счастья и дальнейших научных успехов!

*Ж. И. Алфёров, А. Л. Асеев, С. В. Богданов,
А. В. Двуреченский, А. В. Латышев,
О. П. Пчеляков, Э. В. Скубневский, Р. А. Сурис,
А. В. Чаплик, В. Г. Хорошевский*